

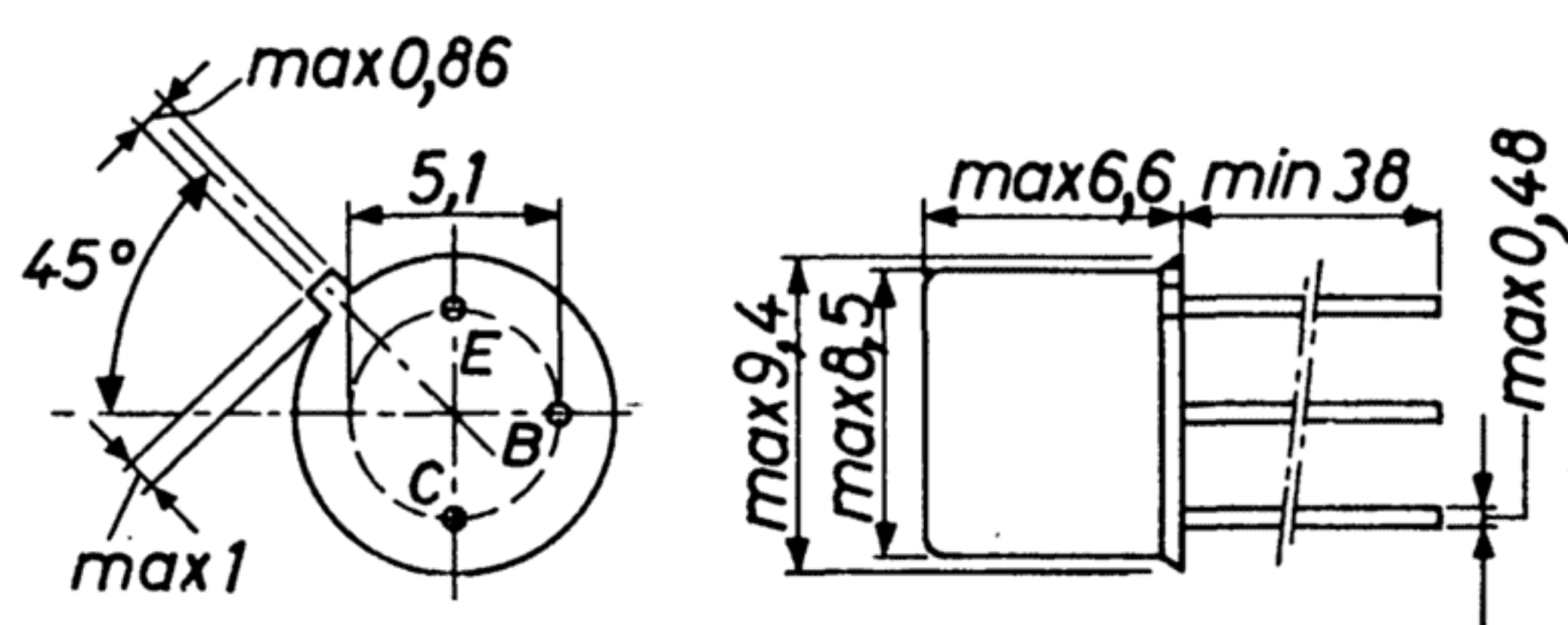
# TRANSISTORS PNP

par alliage au silicium

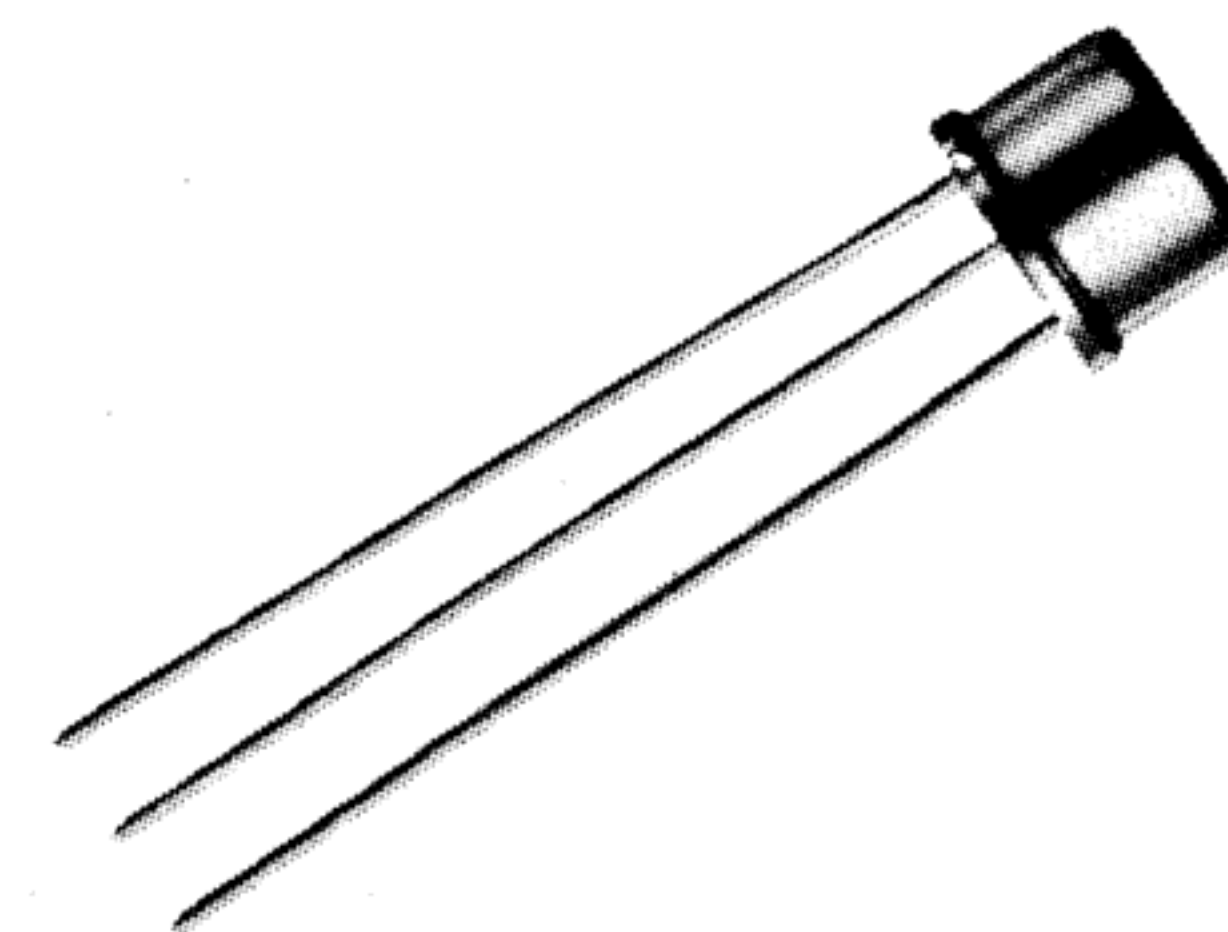
**BCY38**  
**BCY39**  
**BCY40**

Les transistors de cette série sont indiqués pour toutes applications professionnelles en basse fréquence et commutation lente à niveau moyen.

Disposition des électrodes  
et encombrement



Boîtier JEDEC TO-5  
base reliée au boîtier  
poids : 0,9 g. environ



dimensions en millimètres

[www.datasheetcatalog.com](http://www.datasheetcatalog.com)

Echelle 1/1

Valeurs limites d'utilisation	Symboles	BCY38	BCY39	BCY40	Unités
Tension collecteur base	$V_{CB}$	-32	-64	-32	V
Tension collecteur émetteur	$V_{CE}$	-32	-64	-32	V
Tension collecteur émetteur à $I_C = 500$ mA	$V_{CE}$	-24	-60	-24	V
Tension émetteur base	$V_{EB}$	-12	-12	-12	V
Courant crête de collecteur	$I_{CM}$	← 500 →			mA
Courant continu de collecteur	$I_C$	← 250 →			mA
Courant crête de base	$I_{BM}$	← -125 →			mA
Courant continu de base	$I_B$	← -125 →			mA
<b>Caractéristiques thermiques</b>					
Puissance de dissipation	$P_{tot}$	← 410 →			mW
Température de jonction	$t_j$	← 150 →			°C
Température de stockage	$t_{stg}$	← -55 à + 150 →			°C
Résistance thermique jonction-air ambiant	$R_{th}$	← 0,3 →			°C/mW
Résistance thermique jonction-boîtier	$R_{th}$	← 0,12 →			°C/mW



**COMPELEC**

18, rue d'Enghien, 75 Paris 10<sup>e</sup>-FRANCE-Tél : (1) 523 15-25 +

TELEX : 28.302 COMPLEC-PARIS

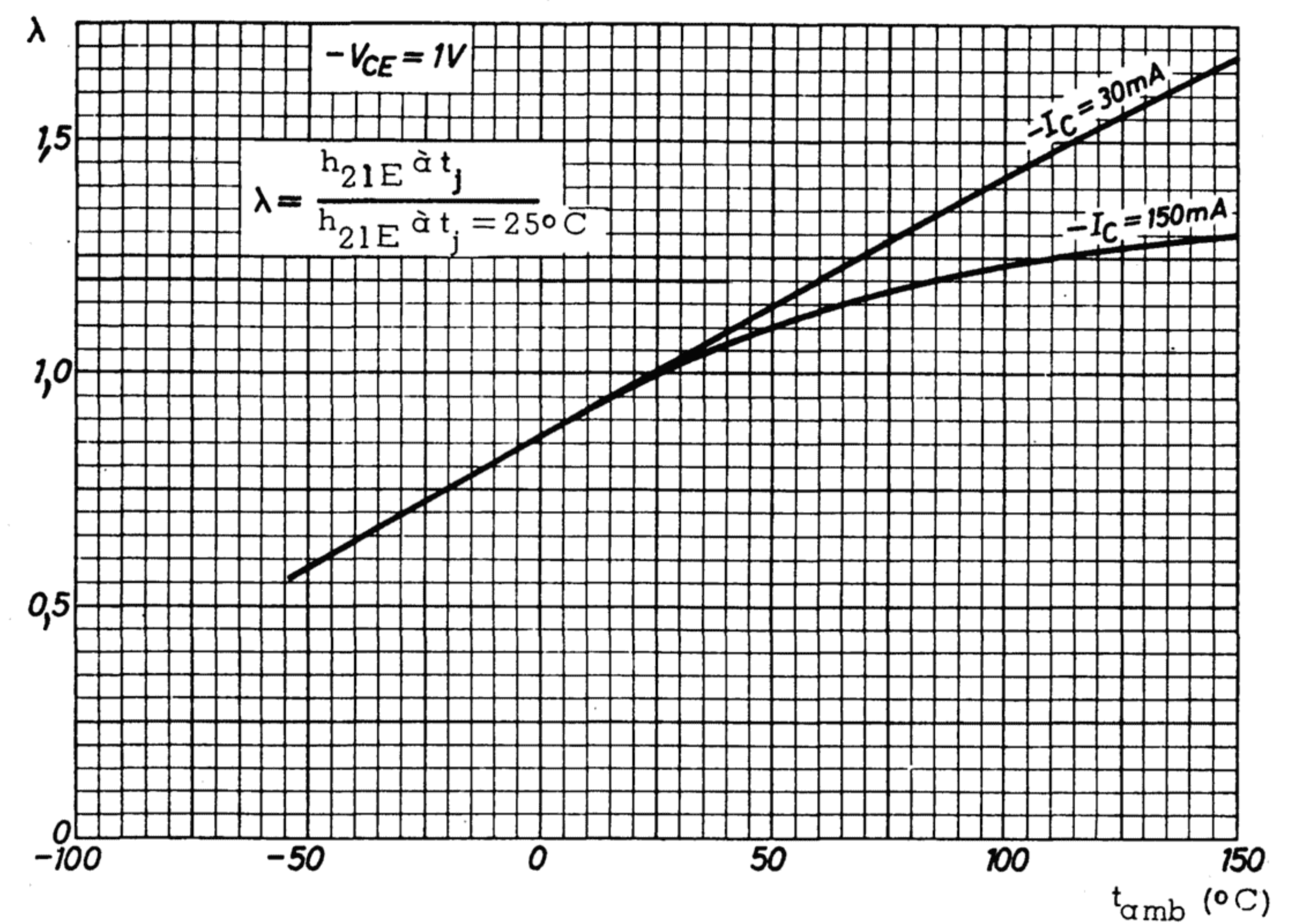
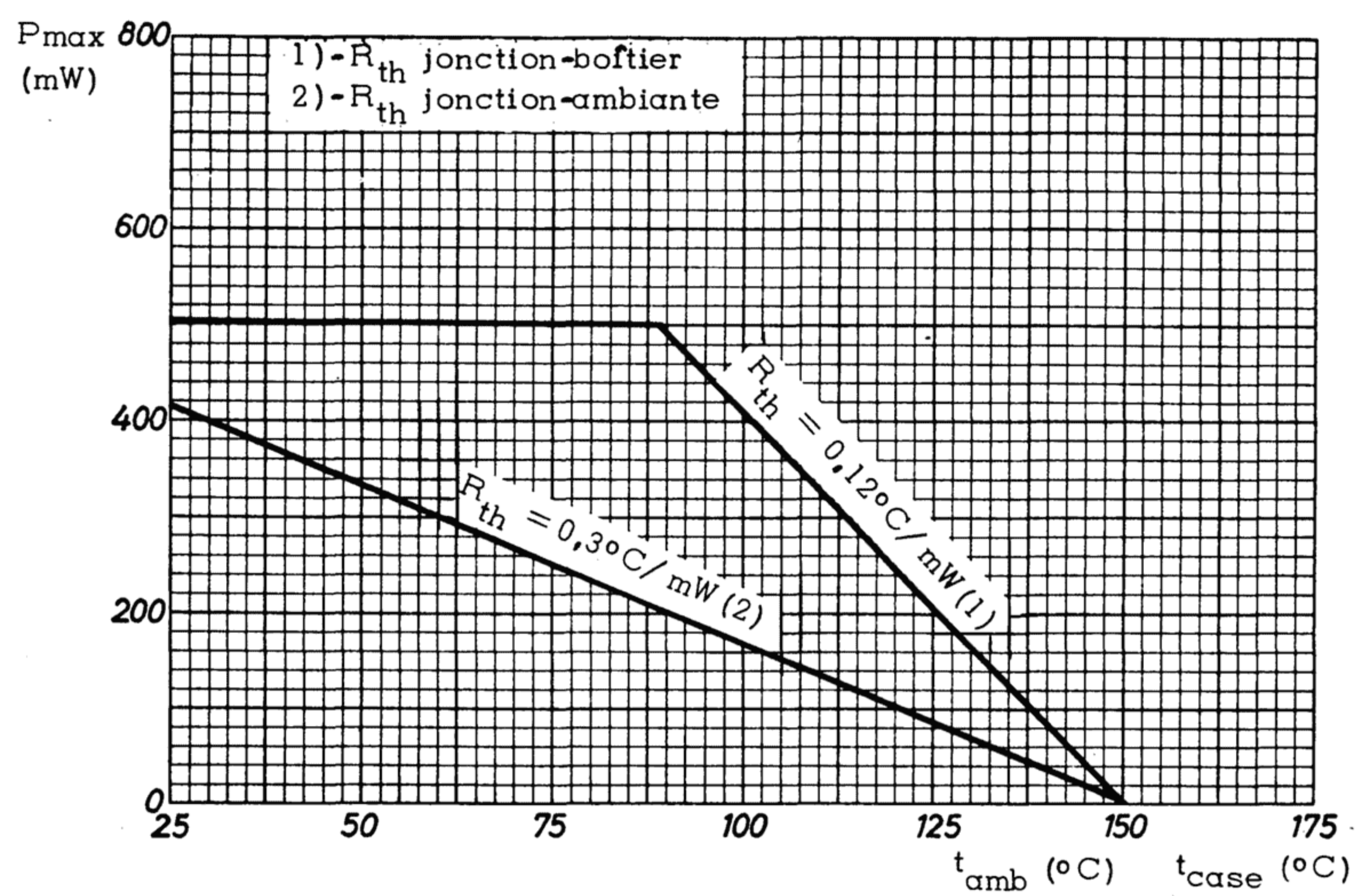
R. C. Seine 65 B 1604

BCY38  
BCY39  
BCY40

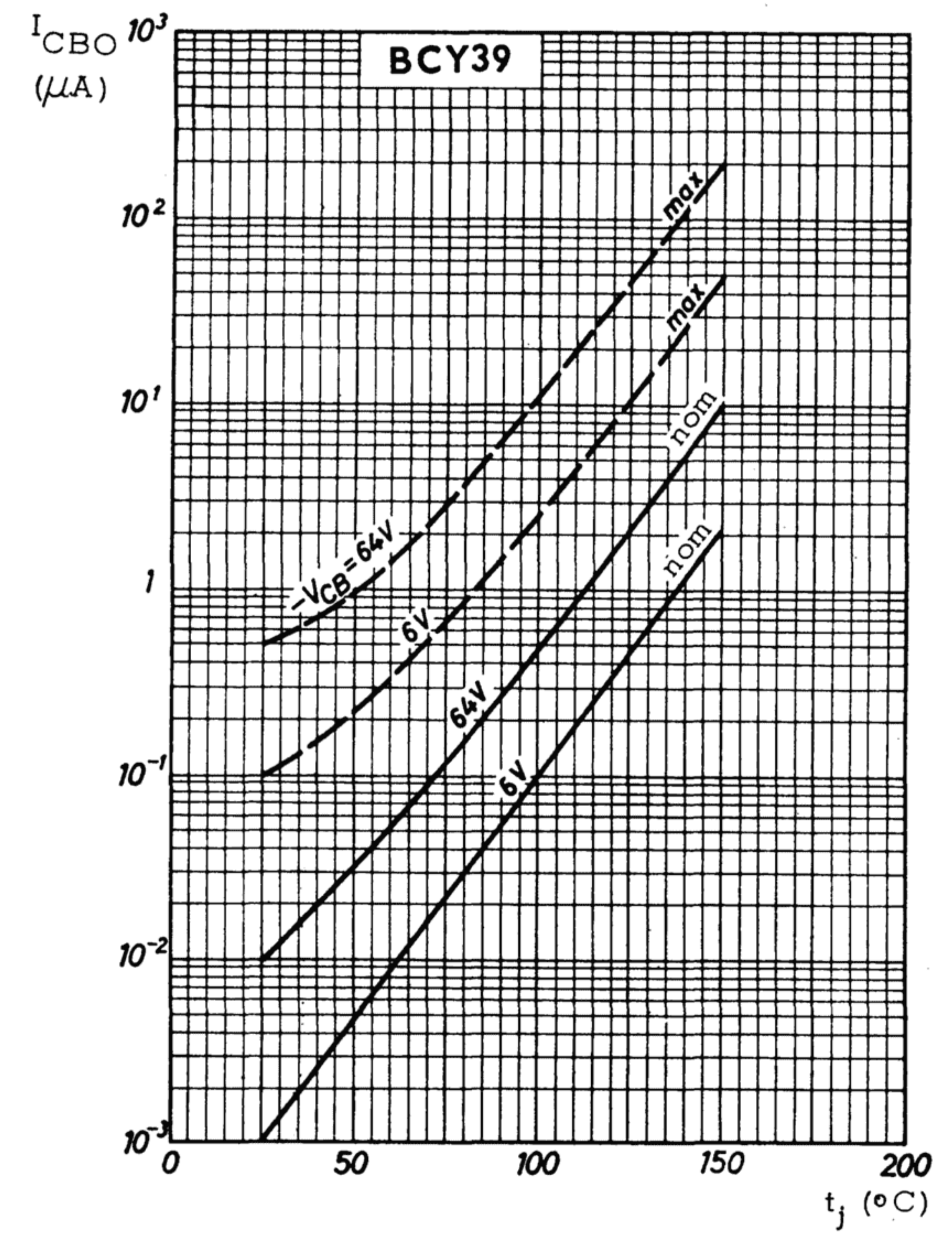
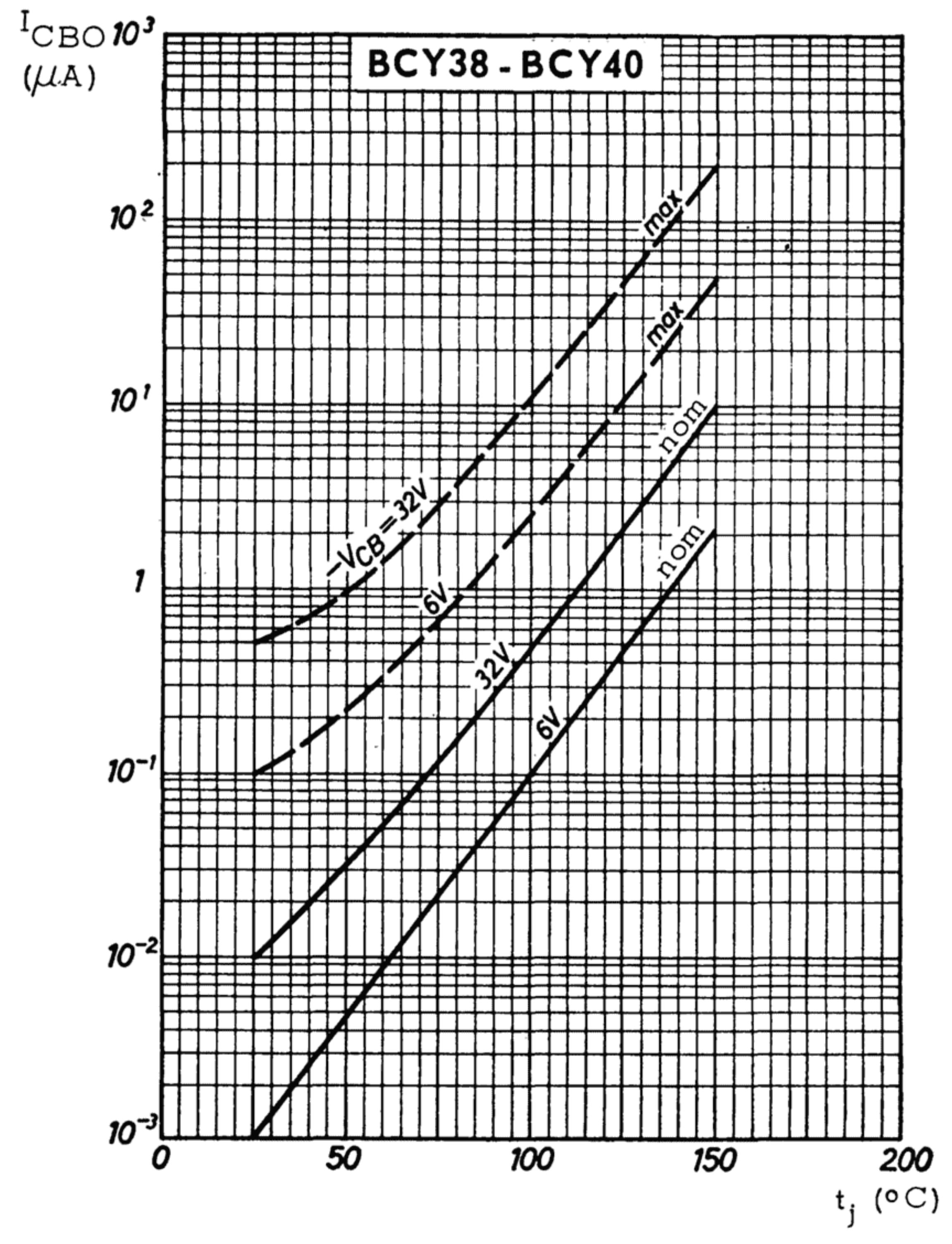
Caractéristiques statiques ( $t_{amb} = 25^{\circ}C$ )	Conditions de mesure	Symboles	BCY38			BCY39			BCY40			Unités
			min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
Courant résiduel du collecteur	$V_{CB} = -6V, I_E = 0,$	$I_{CBO}$		1	100		1	100		1	100	nA
	$V_{CB} = -6V, I_E = 0, t_j = 100^{\circ}C$	$I_{CBO}$		0,1	2,5		0,1	2,5		0,1	2,5	$\mu A$
Courant résiduel de l'émetteur	$V_{EB} = -6V, I_C = 0,$	$I_{EBO}$		1	100		1	100		1	100	nA
	$V_{EB} = -6V, I_C = 0, t_j = 100^{\circ}C$	$I_{EBO}$		0,1	2,5		0,1	2,5		0,1	2,5	$\mu A$
Tension de saturation collecteur - émetteur	$I_C = -125mA, I_B = 17mA$	$V_{CEsat}$		-460	-880		-360	-880		-330	-880	mV
Rapport de transfert direct du courant (gain statique)	$V_{CE} = -1V, I_C = -30mA$	$h_{21E}$	12	20		12	30		22	35		
	$V_{CE} = -1V, I_C = -150mA$	$h_{21E}$	10	13	30	10	19	50	15	23	120	
	$V_{CB} = -6V, I_{EM} = 330mA (1)$	$h_{21E}$		10			10			10	15	
<b>Caractéristiques dynamiques</b>												
Fréquence de transition	$V_{CE} = -6V, I_C = 1mA$	$f_T$	0,45	1,5		0,45	1,5		0,85	2,5		MHz
Facteur de bruit	$V_{CE} = -2V, I_E = 500\mu A$ $f = 1KHz, R_G = 500\Omega$	F		8	20		8	20		8	20	dB
Impédance de base	$f = 1KHz, V_{CE} = -6V, I_C = -1mA$	$ Z_{12b} $		80	250		90	250		110	250	$\Omega$
Capacité de collecteur	$V_{CB} = 6V, I_E = 0$	$C_c$		75	150		75	150		75	150	pF
Rapport de transfert direct du courant (gain dynamique)	$V_{CE} = -6V, I_C = -10mA$ $f = 1KHz$	$h_{21e}$	15	27	100	15	35	100	30	45	160	

1) Mesuré en impulsions.

[www.datasheetcatalog.com](http://www.datasheetcatalog.com)



[www.datasheetcatalog.com](http://www.datasheetcatalog.com)



BCY38  
BCY39  
BCY40

www.datasheetcatalog.com

